

ミュート用トランジスタ

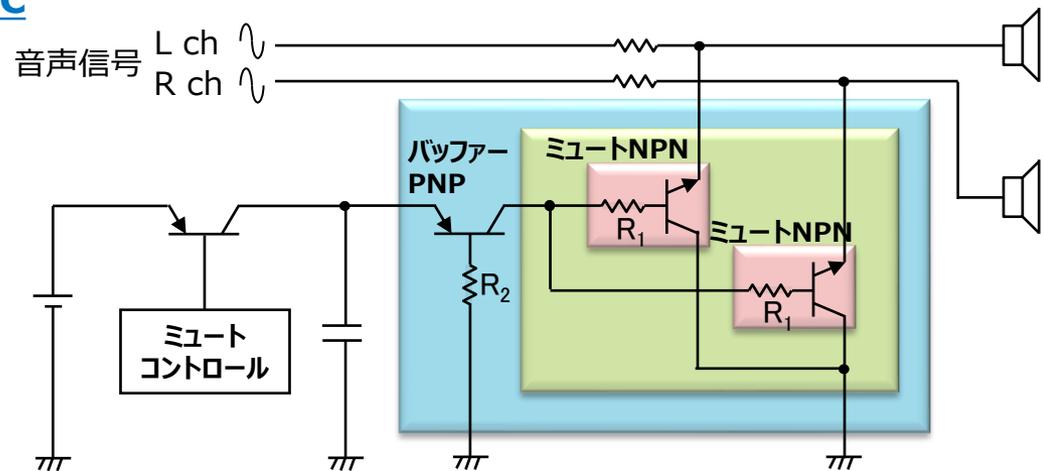
低 R_{on} 、高 V_{EBO} であり音声ミュート用トランジスタとして最適！

INC2002AX1、RTANシリーズ、複合etc

□特徴

- コレクタ・エミッタ間飽和電圧が小さく、音声ミュート用として最適です。
- V_{EBO} が高く逆流防止用ダイオードが不要です。
- 逆方向 h_{FE} が高く、負側の信号の音声ミュートも可能です。
- 小型面実装パッケージに加え、抵抗内蔵タイプ、複合タイプ(2個入り)、バッファ-PNP複合タイプも取り揃えており、セットの小型化、高密度実装が可能です。

□応用例 2chミュート回路



ミュートトランジスタ、抵抗付きミュートトランジスタ及び2個入りタイプ (* : SC-59、SC-70、SC-75A、2個入り : SC-88、SC-88A)

	品名①	品名② (SC88)	品名② (SC88A)	$V_{CBO}(V)$	$V_{EBO}(V)$	$V_{CEO}(V)$	$I_C(mA)$	h_{FE}	$R_{on}(\Omega)$	$R_1(k\Omega)$	$V_{CBO}(V)$	$V_{EBO}(V)$
ミュートトランジスタ	INC2002A*1	RT3CXXM	-	50	50	20	600	820~2500	0.65	-	50	50
抵抗付きミュートトランジスタ	RTAN230*	RT3X99M	RT2N62M	40	40	20	400	820~2500	0.70	2.2	40	40
	RTAN430*	RT3XAAM	RT2N63M	40	40	20	400	820~2500	0.70	4.7	40	40
	RTAN140*	RT3XBBM	RT2N64M	40	40	20	400	820~2500	0.94	10	40	40

ミュートトランジスタとバッファ-PNPの複合タイプ (SC-88)

品名	$V_{CBO}(V)$	$V_{EBO}(V)$	$V_{CEO}(V)$	$I_C(mA)$	h_{FE}	$R_{on}(\Omega)$	$R_1(\Omega)$	バッファPNP
RT3Y97M	40	40	15	200	820~2500	1.6	2.2	$V_{CBO}=-9V$ 、 $V_{EBO}=-50V$ 、 $V_{CEO}=-9V$ $h_{FE}=10(Typ)$ $R_2=10k\Omega(Typ)$
RT3YA7M	40	40	15	200	820~2500	1.8	4.7	
RT3YB7M	40	40	15	200	820~2500	2.0	10	